

μ PA75V

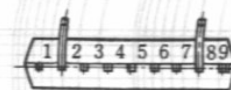
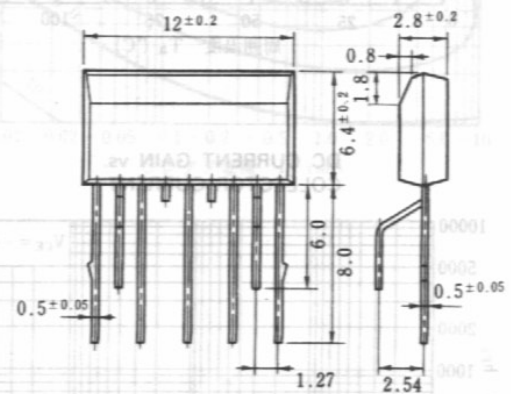
PNPエピタキシャル形
シリコン複合トランジスタ
低周波低雑音差動増幅用

PNP Silicon Epitaxial Compound Transistor
Differential Amplifier

特長/FEATURES

- 1 chip 構造であるため、ペア性 ($\Delta V_{BE} = 2 \text{ mV TYP.}$) が良く、熱バランスにも優れていますので、EQアンプ、メインアンプにおける差動増幅に最適です。
- 高耐圧、高 h_{FE} です。
 $V_{CEO} < -80 \text{ V}$
 $h_{FE} = 400 \text{ TYP.}$
- 低雑音です。
 $NV < 80 \text{ mV (} R_G = 100 \text{ k}\Omega, G_V = 80 \text{ dB, FLAT)}$

外形図/PACKAGE DIMENSIONS
(Unit: mm)



電極接続

1. ベース 1
2. コレクタ 1
3. エミッタ 1
4. NC
5. Sub
6. NC
7. エミッタ 2
8. コレクタ 2
9. ベース 2

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ \text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5.0	V
コレクタ電流	I_C	-50	mA
全 損 失	P_T	300	mW/unit
ジャンクション温度	T_j	125	$^\circ \text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55 ~ +125	$^\circ \text{C}$

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ \text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -70 \text{ V}, I_E = 0$			-1.0	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -4.0 \text{ V}, I_C = 0$			-1.0	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -6.0 \text{ V}, I_C = -0.1 \text{ mA}$	150	350		
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = -6.0 \text{ V}, I_C = -1.0 \text{ mA}$	200	400	800	
直流電流増幅率比	$h_{FE小}/h_{FE大}$	$V_{CE} = -6.0 \text{ V}, I_C = -1.0 \text{ mA}$	0.9		1.0	
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -6.0 \text{ V}, I_C = -1.0 \text{ mA}$	-0.55		-0.65	V
直流ベース電圧差	ΔV_{BE}	$V_{CE} = -6.0 \text{ V}, I_C = -1.0 \text{ mA}, \Delta V_{BE} = V_{BE1} - V_{BE2} $		2.0	5.0	mV
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -10 \text{ mA}, I_B = -1.0 \text{ mA}$			-0.3	V
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = -30 \text{ V}, I_E = 0, f = 1.0 \text{ MHz}$		4.0	6.0	pF
雑 音 電 圧	NV	測定回路参照			80	mV

h_{FE} 区分(h_{FE2}) / P: 200~400 F: 300~600 E: 400~800